(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-352483 (P2002-352483A)

(43)公開日 平成14年12月6日(2002.12.6)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)			
G11B	7/26	5 3 1	G11B	7/26	5 3 1	4K018		
C 2 2 C	28/00		C 2 2 C	28/00	В	4 K 0 2 9		
C 2 3 C	14/34		C 2 3 C	14/34	Α	5 D 1 2 1		
// B22F	3/14		B 2 2 F	3/14	Α			

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

(21)出顯番号	特顏2001-156922(P2001-156922)	(71) 出顧人	000006264 三菱マテリアル株式会社			
(22)出顧日	平成13年5月25日(2001.5.25)		東京都千代田区大手町1丁目5番1号			
		(72)発明者	白井 孝典			
			兵庫県三田市テクノパーク12-6 三菱マ			
			テリアル株式会社三田工場内			
		(72)発明者	小田 淳一			
			兵庫県三田市テクノパーク12-6 三菱マ			
			テリアル株式会社三田工場内			
		(74)代理人	100076679			
		, , , , , , ,	弁理士 富田 和夫 (外1名)			
			·			
			日か田で飲			

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 拡散防止膜形成用ターゲット

(57)【要約】

【課題】 拡散防止膜形成用ターゲットを提供する。 【解決手段】 $Ge:50\sim95$ 原子%、 $Cr:5\sim50$ 原子%からなる組成を有する拡散防止膜形成用ターゲットにおいて、Ge 索地中に、 $Cr_{11}Ge_{13}$ 相、 $Cr_{3}Ge$ e 相が $Cr_{11}Ge_{13}$ 相により包囲された目玉状複合相、または $Cr_{11}Ge_{13}$ 相および目玉状複合相が混合して分散している組織を有することを特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】Ge:50~95原子%、Cr:5~50 原子%からなる組成を有する拡散防止膜形成用ターゲッ

Ge素地中にGe-Cr金属間化合物相が分散している 組織を有することを特徴とする拡散防止膜形成用ターゲ

【請求項2】前記Ge-Cr金属間化合物相は、Cr11 Ge,相であることを特徴とする請求項1記載の拡散防 止膜形成用ターゲット。

【請求項3】前記Ge-Cr金属間化合物相は、Cr, Ge相がCr., Ge., 相により包囲された目玉状複合相 であることを特徴とする請求項1記載の拡散防止膜形成 用ターゲット。

【請求項4】前記Ge-Cr金属間化合物相は、Cr,, Ge,,相と、Cr,Ge相がCr,,Ge,,相により包囲 された目玉状複合相とが混合して分散している混合相で あることを特徴とする請求項1記載の拡散防止膜形成用 ターゲット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、CD-RW、D VD-RAM、MO、MDなどの光記録媒体、特にCD - R W光記録媒体における拡散防止膜を作製するための ターゲットに関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般に、光ビームを用いて情報の記録お よび消去を行う光ディスクなどの光記録媒体の膜構造 は、図5の断面図に示されるように、基板1の表面に下 部誘電体膜2を形成し、この下部誘電体膜2の上に拡散 30 防止膜6を形成し、この拡散防止膜6の上に光記録膜3 を形成し、この光記録膜3の上に拡散防止膜6を形成 し、この拡散防止膜6の上に上部誘電体膜4を形成し、 との上部誘電体膜4の上に反射膜5を形成した構造とな っており、実用の光記録媒体は前記反射膜5を保護する ために反射膜5の上にさらに保護膜(図示せず)を形成 した構造となっている。かかる膜構造の光記録媒体は、 レーザー光の照射により光記録膜3を結晶状態と非晶質 状態との間で相変化させ、情報の記録・消去による書き 換えを行う。

【0003】前記光記録媒体を構成する基板1は厚さ: 0. 5~3 mm程度の透明な樹脂やガラスなどからなる 円板で構成されており、基板を構成する樹脂としては、 アクリル樹脂、ポリカーボネート、エポキシ樹脂、ポリ オレフィン樹脂、ポリメチルメタクリレート(PMM A) 樹脂、ポリイミド樹脂などが使用されている。 【0004】また、前記光記録膜3は、In-Se系組 成を有する光記録膜、「n-Se-Te系組成を有する 光記録膜、Ge-Sb-Te系組成を有する光記録膜、 Pd-Ge-Sb-Te系組成を有する光記録膜、Pt 50 挟んで下部誘電体膜2および上部誘電体膜4の硫黄成分

-Ge-Sb-Te系組成を有する光記録膜、Nb-G e-Sb-Te系組成を有する光記録膜、Ni-Ge-Sb-Te系組成を有する光記録膜、Co-Ge-Sb -Te系組成を有する光記録膜、In-Ag-Te-S b系組成を有する光記録膜、Ge-Sb-Te系組成を 有する光記録膜などが知られており、この光記録膜3は 通常10~45nmの厚さを有し、スパッタにより形成 される。これら光記録膜の内でも特にIn-Ag-Te - S b 系組成を有する光記録膜を積層した光記録媒体は 10 オーバーライト可能回数が大で寿命が長く、さらに信頼 性が高いところから広く使用されている。 そして前記1 n-Ag-Te-Sb系組成を有する光記録膜は、原子 %c, 0<1n≤30, 0<Ag≤30, 10≤Te≤ 50. 10≤Sb≤80の組成を有し、この組成を有す る光記録膜は3≦ I n ≦30、2≦A g ≦30、10≦ Te≦50. 15≦Sb≦83の組成を有するターゲッ トを用いてスパッタすることにより形成されることが知 られている(特開平8-22644号公報参照)。

2

【0005】前記基板1の上に形成される下部誘電体膜 20 2は記録時に光記録膜3から基体1に伝わる熱を遮断し て基体1を保護する作用をなし、一方、光記録膜3の上 に形成される上部誘電体膜4は光記録膜3を保護すると 共に、記録後、光記録膜に残った熱を熱伝導により放出 する作用を有する。前記下部誘電体膜2 および上部誘電 体膜4は、通常、二酸化ケイ素を10~30原子%含有 し、残部が硫化亜鉛からなる硫化亜鉛-二酸化ケイ素系 誘電体膜で構成されている。そして前記下部誘電体膜2 および上部誘電体膜4はいずれも純度:99.999重 量%以上の二酸化ケイ素:10~30原子%を含有し、 残部が純度:99.999重量%以上の硫化亜鉛からな り、相対密度が90%以上有する焼結体で構成されたタ ーゲットをスパッタすることにより形成される。

【0006】さらに、前記反射膜5は、通常、A1.A u, Ag, Cu, Cr, Ti, Ta, Mo, Ptなど単 体あるいはこれら1種以上の合金など高反射率金属から なる厚さ1~200nmのスパッタ膜で構成されてい る。また実用に際して反射膜5の上に形成する保護膜 (図示せず)が形成される。この保護膜(図示せず)は 耐摩耗性および耐食性を有する種々の有機化合物をスピ 40 ンコート、スプレーコート、ディビングすることにより 形成してもよく、さらに光を透過する酸化物、窒化物、 炭化物などの膜を使用しても良い。

【0007】下部誘電体膜2および上部誘電体膜4はい ずれも硫化亜鉛を主成分としており、硫化亜鉛を主成分 とする下部誘電体膜2 および上部誘電体膜4 が光記録膜 3に直接接すると、誘電体膜の硫黄成分が光記録膜3に 拡散し、そのために光記録膜3の性能の劣化が早くな る。そとで拡散防止膜6を下部誘電体膜2と光記録膜3 の間および上部誘電体膜4と光記録膜3の間にそれぞれ 3

が光記録膜3に拡散するのを防止している。この拡散防止膜6は、Ge:50~95原子%、Cr:5~50原子%からなる組成を有するターゲットを用い、スパッタリングにより形成することも知られている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかし、市販の拡散防止膜形成用ターゲットは、密度および強度が低く、割れが発生しやすいために取り扱いに注意が必要であり、さらにスパッタリング中に冷却水圧力によるパッキングブレートの湾曲などによりターゲットに割れが頻発するな 10 どの欠点があった。

[0009]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは、市販の拡散防止膜形成用ターゲットよりも一層高密度および高強度を有する拡散防止膜形成用ターゲットを得るべく研究を行った。その結果、(イ)市販の拡散防止膜形成用ターゲットは、金属Cr相がGe-Cr金属間化合物相に囲まれた状態で金属Cr相がGe素地中に分散した組織を有していたが、Cr相を消滅させてGe素地中にGe-Cr金属間化合物相のみが分散している組織 20を有する拡散防止膜形成用ターゲットを作製したところ、密度および強度が格段に向上し、(ロ)前記Ge-Cr金属間化合物相のみが分散している組織は、Ge素地中に、Cr11Ge19相、Cr11Ge19相により包囲された目玉状複合相、またはこれらCr11Ge19相および目玉状複合相が混合して分散している混合相である、という研究結果が得たのである。

【0010】との発明は、かかる研究結果に基づいて成 されたものであって、(1)Ge:50~95原子%、 Cr:5~50原子%からなる組成を有する拡散防止膜 30 形成用ターゲットにおいて、Ge素地中にGe-Cr金 属間化合物相が分散している組織を有する拡散防止膜形 成用ターゲット、(2)Ge:50~95原子%、C r:5~50原子%からなる組成を有する拡散防止膜形 成用ターゲットにおいて、Ge素地中に、Cr,,Ge,, 相からなるGe-Cr金属間化合物相が分散している組 織を有する拡散防止膜形成用ターゲット、(3)Ge: 50~95原子%、Cr:5~50原子%からなる組成 を有する拡散防止膜形成用ターゲットにおいて、Ge素 地中に、Cr,Ge相がCr,,Ge,,相により包囲され た目玉状複合相からなるGe-Cr金属間化合物相が分 散している組織を有する拡散防止膜形成用ターゲット、 (4) Ge:50~95原子%、Cr:5~50原子% からなる組成を有する拡散防止膜形成用ターゲットにお いて、Ge素地中に、Cr,,Ge,,相およびCr,Ge 相がCr、、Ge、相により包囲された目玉状複合相が混 合して分散している組織を有する拡散防止膜形成用ター ゲット、に特徴を有するものである。

【0011】 この発明の拡散防止膜形成用ターゲット 織写真を図3に示した。表1において、Ge緊地中にCは、Ge粉末:50~95原子%、Cr粉末:5~50 50 r,,Ge,,相が80%以上占めて分散している組織をC

原子%となるように配合し、混合して混合粉末を作製し、 この混合粉末をホットプレスすることにより作製するこ とができる。そのホットプレス条件は、原料粉末の粒 径、ホットプレスの温度、圧力などによって変化する。 しかし、いずれにしても金属Cr相が消滅してGe-Cr金属間化合物相となるような条件でホットプレスする ことが必要である。

[0012] とのようにして得られたとの発明の拡散防 止膜形成用ターゲットは、図1の写生図に示されるGe 累地7中にCr,,Ge,,相8からなるGe-Cr金属間 化合物相が分散している組織、図2の写生図および図3 の金属組織写真に示されるGe 索地7中にCr,Ge相 9がCr.,Ge.,相8により包囲された目玉状複合相1 OからなるGe-Cr金属間化合物相が分散している組 織、または、図示してはいないが、図1に示される組織 と図2に示される組織が混在した組織を有しており、こ れら組織を有するとの発明の拡散防止膜形成用ターゲッ トは高密度および高強度を有するのである。とれに対し て、市販の拡散防止膜形成用ターゲットは、図4の写生 図に示されるように、金属Cr相llがCr,Ge相9 およびCr11Ge1,相8からなるGe-Cr金属間化合 物相に囲まれた状態で金属Cr相11が残存している組 織を有しており、この市販の拡散防止膜形成用ターゲッ トは密度および強度が低いのである。

[0013]

【発明の実施の形態】表1に示される平均粒径のGe粉末およびCr粉末を用意し、これら原料粉末を表1に示される割合で配合し、この配合粉末をポリポットの中に入れ、5時間湿式混合し、得られた混合粉末をホットプレスの金型に充填し、真空雰囲気中、表1に示される温度および圧力の条件でホットプレスすることによりホットプレス体を作製し、このホットプレス体を機械加工することにより直径:200mm、厚さ:6mmの寸法を有する本発明拡散防止膜形成用ターゲット1~3を作製した。さらに、比較のために、市販の拡散防止膜形成用ターゲットを用意し、これを従来拡散防止膜形成用ターゲットとした。

r,,Ge,,相組織、Ge索地中にCr,Ge相がCr,,Ge,相により包囲された目玉状複合相が80%以上占めている組織を目玉状複合相組織、Cr,,Ge,相および目玉状複合相が混合して分散しているためにどちらにも分類できない組織を混合相組織、金属Cr相がCr,Ge,相により包囲されて金属Cr*

* 相が残存している組織を金属Cr残存相組織、として示し、さらにこれら本発明拡散防止膜形成用ターゲット1 ~3 および従来拡散防止膜形成用ターゲットの密度および抗折強度を測定し、その結果を表1に示した。

[0015]

【表1】

拡散防 止膜形 成用夕		原料粉末の配合組成(原子%)				- 1 - 1 - 7 /2 PH		ターゲットの成			特性		
		Ge粉末		Cr粉末		ホットプレス条件		分組成(原子%)		組織の種類	相対密度	抗折強度	
	成用ラ ーゲッ ト	平均粒径 (μm)		平均粒径 (μm)		组度 (°C)	時間 (h)	圧力 MPa)	Ge	Сr	ALIMAY PLANSE	(%)	(MPa)
*	1	100	50	100	50	870	3	24.5	50	50	目玉状妆合相組織	99	20.5
発	2	100	80	50	20	870	3	24.5	80	20	混合相組織	95	22. 2
明	3	100	95	50	5	870	4	24.5	95	5	Cr ₁₁ Ge ₁ 相組織	93	23.0
12	来	* 市販の拡散防止膜形成用ターゲット				80	20	金属Cr残存相組織	80	17.0			

但し、CrigGei。相組織:Ge素地中に、CrigGei。相が80%以上占めて分散している組織。

目玉状複合相組織:Ge素地中に、Cr、Ge相がCr、IGe、相により包囲された目玉状複合相が80%以上占めて分散している組織、

混合相組織:Ge素地中に、Cr₁₄Ge₁₁相および目玉状複合相が混合して分散している組織、

金属Cr残存相組織:Ge素地中に、金属Cr相がCr,Ge相およびCr,Ge相に包囲されて残存し分散している組織

[0016]

【発明の効果】表1に示される結果から、金属Cr残存相組織を有しない本発明拡散防止腹形成用ターゲット1 20~3は、金属Cr残存相組織を有する従来拡散防止腹形成用ターゲットに比べて、密度および抗折強度が格段に優れていることが分かる。

【図面の簡単な説明】

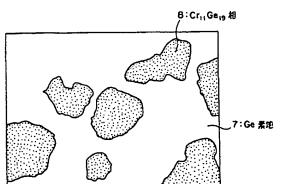
【図1】Ge素地中にCr₁₁Ge₁,相が分散した組織の 写生図である。

【図2】Ge素地中にCr,Ge相がCr,,Ge,,相により包囲された目玉状複合相が分散した組織の写生図である。

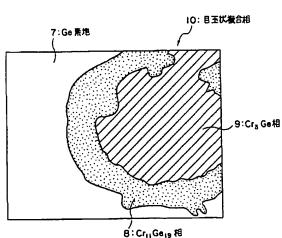
【図3】Ge素地中にCr,Ge相がCr,Ge,相により包囲された目玉状複合相が分散した組織の金属顕微鏡組織写真である。

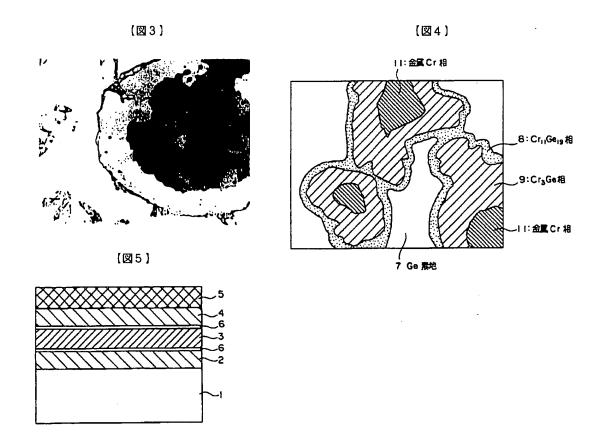
- ※ [図4] 金属Cr相をCr,Ge相が包囲した状態で金属Cr相が残存している組織の写生図である。
- 20 【図5】光記録媒体の膜構造断面図である。 【符号の説明】
 - 1 基板
 - 2 下部誘電体膜
 - 3 記錄膜
 - 4 上部誘電体膜
 - 5 反射膜
 - 6 拡散防止膜
 - 7 Ge素地
 - 8 Cr,,Ge,,相
- 9 Cr,Ge相
 - 10 目玉状複合相
 - 11 金属Cr相

【図1】



[図2]





フロントページの続き

F ターム(参考) 4K018 AA40 BA20 BC12 EA01 KA32 4K029 BC07 BD00 DC05 5D121 EE03 EE09